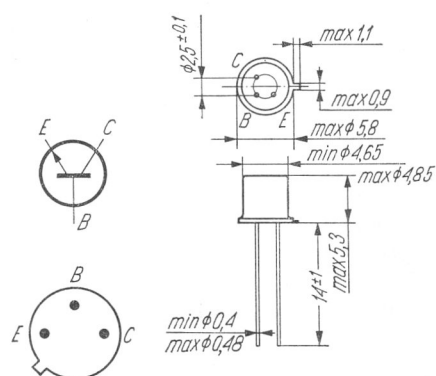




Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny *n-p-n* w obudowie metalowej, kolektor połączony z obudową

Zastosowanie: układy przełączające

Typy podobne: BSY62 (Siem), SF136 (RFT), 2N708 (Se, Tel, Tex), BSY19 (Ph)

Rys. 1-806. KS500

Wartości charakterystyczne¹⁾

U_{CB0}	> 25	V	przy $I_{CB0} = 1 \mu A$
U_{CE0}	> 14	V	przy $I_{CE} = 10 \text{ mA}$
U_{EB0}	> 5	V	przy $I_{EB} = 10 \mu A$
h_{21E}	> 20		przy $U_{CE} = 1 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$
f_T	> 200	MHz	przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$
I_{CB0}	33 > 500	nA	przy $U_{CB} = 15 \text{ V}$
U_{CEsat}	0,15 < 0,6	V	przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_B = 1 \text{ mA}$
U_{BEsat}	0,75 < 0,9	V	przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_B = 1 \text{ mA}$
C_{22b}	4 < 5	pF	przy $U_{CB} = 5 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$

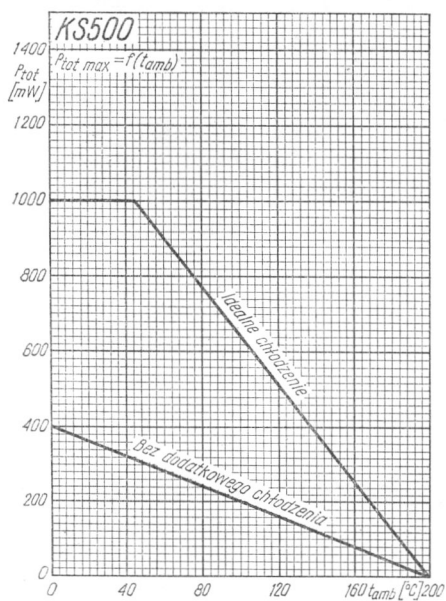
Wartości graniczne

$U_{CB0} \text{ max}$	25	V	$I_B \text{ max}$	20	mA
$U_{CE0} \text{ max}$	14	V	$P_{tot} \text{ max}$	300 ²⁾	mW
$U_{EB0} \text{ max}$	5	V	$t_j \text{ max}$	200	°C
$I_C \text{ max}$	200	mA	t_{stg}	-65 ÷ +200	°C
$I_E \text{ max}$	200	mA			

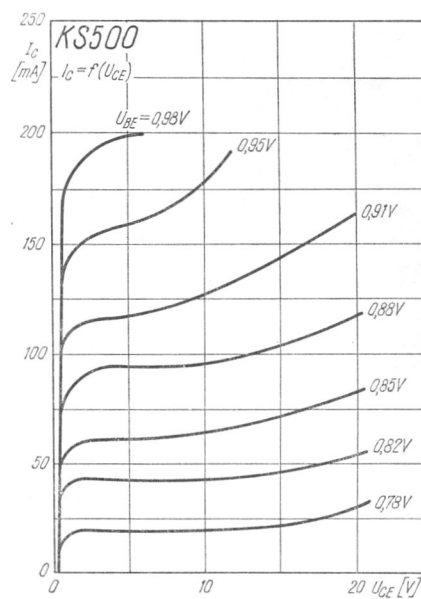
¹⁾ $t_{amb} = \sim 25^\circ C$

²⁾ $t_{amb} \leq 45^\circ C$

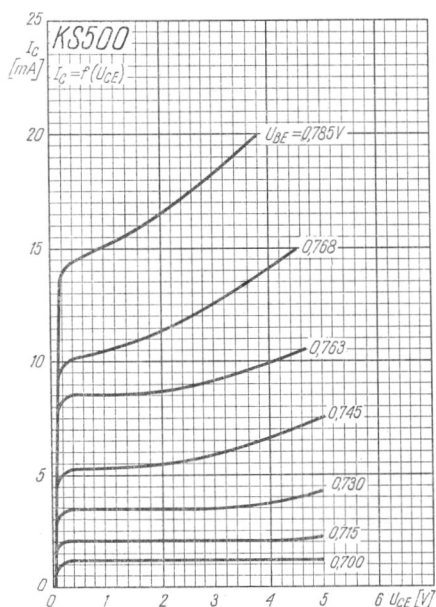
³⁾ idealne chłodzenie



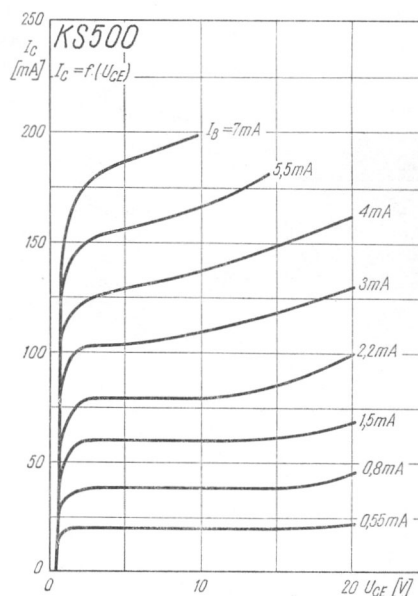
Rys. 1-807. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia



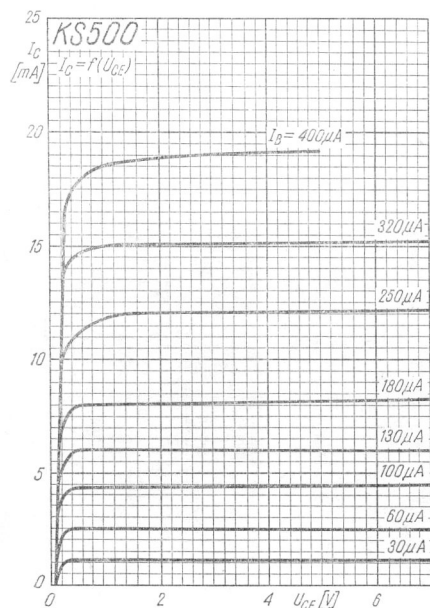
Rys. 1-808. Charakterystyki wyjściowe



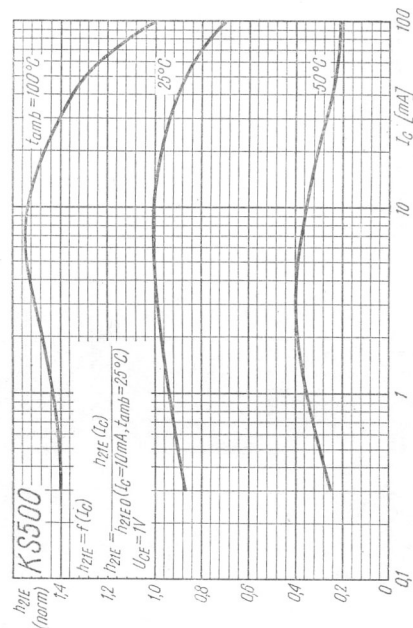
Rys. 1-809. Charakterystyki wyjściowe



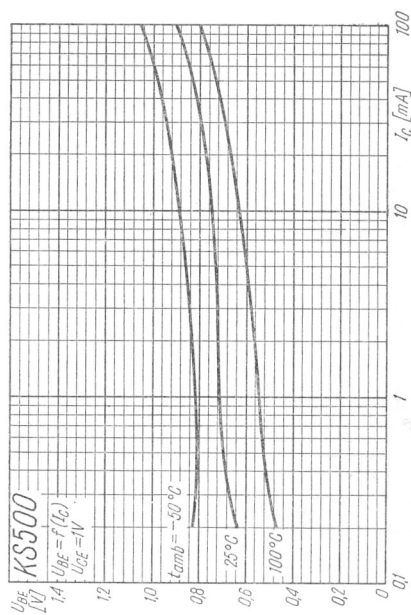
Rys. 1-810. Charakterystyki wyjściowe



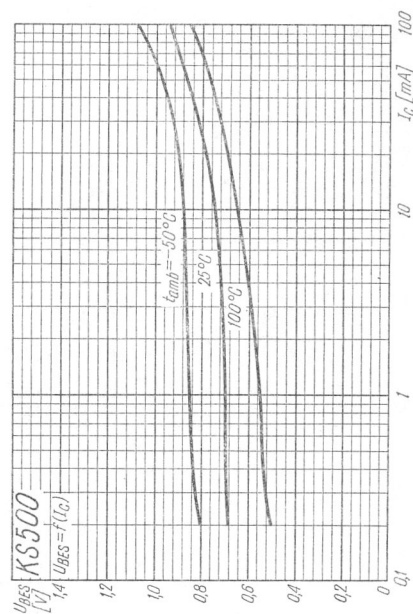
Rys. 1-811. Charakterystyki wyjściowe



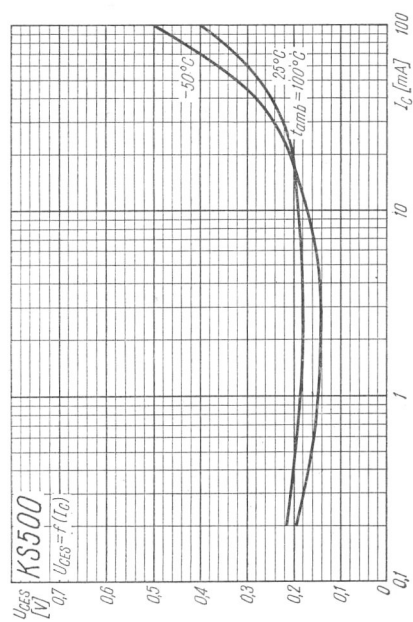
Rys. 1-812. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



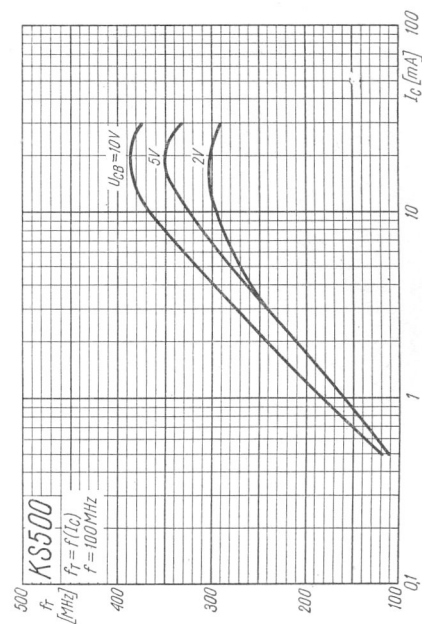
Rys. 1-813. Zależność napięcia U_{BE} od prądu kolektora



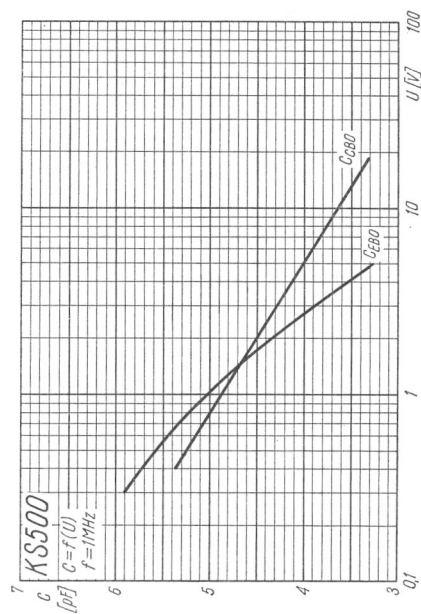
Rys. 1-814. Zależność napięcia U_{BE_S} od prądu kolektora



Rys. 1-815. Zależność napięcia U_{CES} od prądu kolektora



Rys. 1-816. Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora



Rys. 1-817. Zależność pojemności C_{EBO} i C_{CBO} od napięcia